

NPN POWER TRANSISTORS
TRANSISTORS DE PUISSANCE

TECHNOLOGICAL DATA
DONNEES TECHNOLOGIQUES

Material : Silicon
 Structure : Planar

Matériau : Silicium
 Structure : Planar

- General purpose
Usage général
- Medium current switching
Commutation moyen courant

ABSOLUTE RATINGS Limiting values (For encapsulated devices) $t_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ and configuration
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION (En boîtier d'origine) $t_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ and configuration

Type	P_{tot} (W)	V_{CBO} (V)	V_{CEO} (V)	V_{EBO} (V)	I_{CM} (A)	t_{stg} ($^{\circ}\text{C}$)		t_j ($^{\circ}\text{C}$)
						min.	max.	max.
J.2N 2890	5 (1)	100	80	5	2 (1)	-65	+200	+200
J.2N 2891	5 (1)	100	80	5	2 (1)	-65	+200	+200
J.71 T2	15 (2)	80	60	5	2 (1)	-65	+175	+175
J.72 T2	15 (2)	80	60	5	2 (1)	-65	+175	+175

- (1) When mounted in TO-39 case, $t_{case} = 25^{\circ}\text{C}$
 Quand la pastille est montée en boîtier TO-39, $t_{case} = 25^{\circ}\text{C}$
- (2) When mounted in F-88 case, $t_{case} = 25^{\circ}\text{C}$
 Quand la pastille est montée en boîtier F-88, $t_{case} = 25^{\circ}\text{C}$

MECHANICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Front metallization : Aluminium (Emitter-base)
 Back metallization : Gold (Collector) See page 60
 All dimensions in μm

Métallisation face avant : Aluminium (Emetteur-base)
 Métallisation face arrière : Or (Collecteur) Voir page 60
 Dimensions en μm

